









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB052N04NGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB052N04NGATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB052N04NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 33µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.2 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPB052N04NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB052N04NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB052N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB052N04NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB051NE8NG(051NE8N)</b> INFINEO IPB051NE8NG(051NE8N) INFINEO</p>	 <p><b>IPB051NE8N G</b> INFINEON IPB051NE8N G INFINEON</p>	 <p><b>IPB054N06N3 G</b> Infineon Technologies IPB054N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB054N08N3 G</b> Infineon Technologies IPB054N08N3 G Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPB051NE8NG</b> INFINEO IPB051NE8NG INFINEO</p>	 <p><b>IPB052N04NG</b> INF IPB052N04NG INF</p>	 <p><b>IPB054N06N3-G</b> INF IPB054N06N3-G INF</p>	 <p><b>IPB052N04N G</b> Infineo IPB052N04N G Infineo</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB052N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB052N04NGATMA1 Datenblatt	IPB052N04NGATMA1-Datenblätter	IPB052N04NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB052N04NGATMA1
IPB052N04NGATMA1 Electronic	IPB052N04NGATMA1-Komponenten	IPB052N04NGATMA1-Verteiler	IPB052N04NGATMA1-Bild	IPB052N04NGATMA1-Teil
IPB052N04NGATMA1 Preis	IPB052N04NGATMA1 Hersteller	IPB052N04NGATMA1 Bild	IPB052N04NGATMA1 Aktie	IPB052N04NGATMA1 Inventar
IPB052N04NGATMA1 Neu	IPB052N04NGATMA1 Original	IPB052N04NGATMA1 garantiert	IPB052N04NGATMA1 RFQ	IPB052N04NGATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited